公益社団法人　砥粒加工学会　次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会　第 112 回研究会

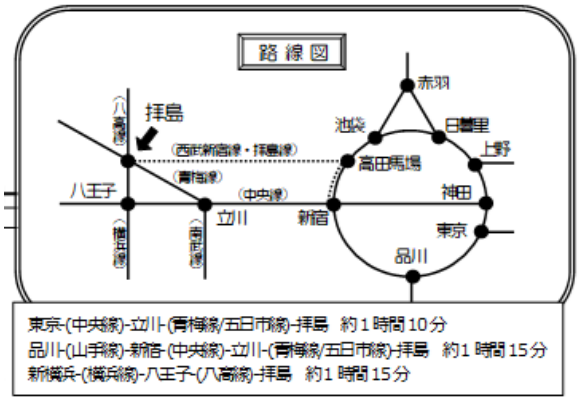
SiC，GaN 先進パワー半導体基板の加工・評価技術最前線（見学会付き）

～　加工方法と加工変質層の深さとの関わり，及びその評価方法について　～

2050 年のカーボンニュートラル社会の実現には EV 化の推進や再生可能エネルギーの主力電源化が不可欠であり，SiC，GaN などの先進パワー半導体を用いた高度なパワエレ技術の普及が重要となっている．そのため，先進パワー半導体基板の量産化・低コスト化が強く望まれているが，これらは難加工材料でもあり、加工に時間がかかるため，製造コスト削減の障壁の一つとなっている．特にウエハの仕上げ加工における加工変質層の議論は非常に重要である．そこで，今回は SiC，GaN などの先進パワー半導体基板の加工方法と加工変質層の深さとの関わり，及びその評価方法について各講師に講演していただく．

また、今回は㈱リガク様のご厚意により，㈱リガク東京工場の見学をさせていただくことになり，時間も 1 日では足りないため 2 日間開催となります．

主　催：
（公社）砥粒加工学会　次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会
日　時：2023 年 12 月 8 日(金)13 時～9 日（土）12 時
開催方式：下記会場（対面）と Cisco Webex Meeting（Web）のハイブリッド形式で開催します。
会　場：㈱リガク　東京工場　セミナー室
JR 青梅線・五日市線・八高線「拝島駅」
西武 拝島線「拝島駅」南口下車徒歩 7 分
https://japan.rigaku.com/downloads//Honsha-map.pdf



1 日目（12 月 8 日）

13:00-13:05 開会挨拶　　委員長　日本大学　山田　高三

13:05-13:55 <講演 1 >　表面改質を援用した GaN 基板のテープ研磨
東北大学　　水谷　正義氏

13:55-14:45 <講演 2 >　先進半導体ウエハの研磨プロセス高度化に関する技術動向
(株)斉藤光学製作所　　千葉　翔悟氏

14:45-14:55 <休憩>

14:55-15:45 <講演 3 >　X 線回折法を用いた先進パワー半導体基板の結晶性評価 –XRD、XRC,XRT–
（株）リガク　稲葉　克彦氏

15:45-16:00 <名刺交換・見学説明>

16:00-17:00 <工場見学会>　※末尾参照（見学会ご参加の制限事項について）

17:00-17:45 移動（リガク東京工場～拝島駅～立川駅～技術交流会場）

18:00-20:00 <技術交流会>　立川駅周辺を予定

―――――――――― 1 日目終了　解散 ――

2 日目（12 月 9 日）

2 日目会場：TKP スター貸会議室 立川
JR 中央線 立川駅北口から徒歩 1 分
東京都立川市曙町 2-12-1 曙ビル 4 階
カンファレンスルーム 4A

10:00-10:05 <2 日目説明等>　　幹事

10:05-10:55 <講演 4 >　SiC ウエハの大口径化と最新加工技術

（株）東京精密　五十嵐 健二氏

10:55-11:45 <講演 5>　ミラー電子式検査装置による SiC ウエハ加工ダメージ非破壊管理の魅力

（株）日立ハイテク　小林 健二氏

11:45-11:55 閉会挨拶　　委員長　日本大学　山田　高三

参加費：研究会：当専門委員会会員：無料，非会員：15,400 円（消費税 10%を含む）
※会員は 5 人／社まで、非会員は 2 人／社まで研究会に参加できます。オンライン参加の場合は PC 接続数に限りがあります。専門委員会事務局（田附）にお問い合わせ下さい。
講演・見学会：対面参加は人数制限がありますので、先着順にて受け付けます。また同業他社様の見学はご遠慮いただく可能性もございますので、予めご了承ください。
技術交流会：会員資格に関わらず 2 名／社まで参加できます。3 人目からは 4,950 円／人（消費税 10%を含む）を徴収します。
（注）「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意下さい。
申込締切日：2023 年 11 月 22 日(木)
（注）当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。
問合せ/申込先：当専門委員会事務局　田附宙美宛
・FAX：048-858-3709，E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp
・申し込みはホームページよりお願いいたします。→https://jsat-sf.jp/event.html